



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111201627 A

(43)申请公布日 2020.05.26

(21)申请号 201780095840.2

(22)申请日 2017.11.10

(85)PCT国际申请进入国家阶段日
2020.04.10

(86)PCT国际申请的申请数据
PCT/CN2017/110560 2017.11.10

(87)PCT国际申请的公布数据
W02019/090733 ZH 2019.05.16

(71)申请人 深圳市柔宇科技有限公司
地址 518172 广东省深圳市龙岗区横岗街
道龙岗大道8288号大运软件小镇43栋

(72)发明人 刘孟宇 秦嬉嬉

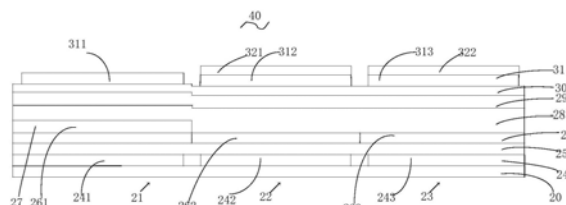
(51)Int.Cl.
H01L 51/50(2006.01)
H01L 51/56(2006.01)

(54)发明名称

OLED显示器件的像素结构、制备方法及OLED
显示结构

(57)摘要

提供一种OLED像素结构的制备方法,包括步骤:制备阳极(24),阳极(24)上划分有一第一次像素区(21)、一第二次像素区(22)与一第三次像素区(23);在阳极(24)上蒸镀形成一空穴传输层(26);在空穴传输层(26)对应第一次像素区(21)的位置蒸镀形成第一单原色空穴传输层(27);制备阴极(31);以及在阴极(31)上对应第二次像素区(22)与第三次像素区(23)的位置分布形成第二单原色滤光片(321)及第三单原色滤光片(322)。还提供一种OLED像素结构及一种OLED显示结构。OLED像素结构、方法及OLED显示结构,同时具有较高的分辨率及较高的发光效率。



专利名称(译)	OLED显示器件的像素结构、制备方法及其OLED显示结构		
公开(公告)号	CN111201627A	公开(公告)日	2020-05-26
申请号	CN201780095840.2	申请日	2017-11-10
[标]申请(专利权)人(译)	深圳市柔宇科技有限公司		
申请(专利权)人(译)	深圳市柔宇科技有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	深圳市柔宇科技有限公司		
[标]发明人	刘孟宇 秦嬉嬉		
发明人	刘孟宇 秦嬉嬉		
IPC分类号	H01L51/50 H01L51/56		
CPC分类号	H01L51/50 H01L51/56		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

提供一种OLED像素结构的制备方法，包括步骤：制备阳极(24)，阳极(24)上划分有一第一次像素区(21)、一第二次像素区(22)与一第三次像素区(23)；在阳极(24)上蒸镀形成一空穴传输层(26)；在空穴传输层(26)对应第一次像素区(21)的位置蒸镀形成第一单原色空穴传输层(27)；制备阴极(31)；以及在阴极(31)上对应第二次像素区(22)与第三次像素区(23)的位置分布形成第二单原色滤光片(321)及第三单原色滤光片(322)。还提供一种OLED像素结构及一种OLED显示结构。OLED像素结构、方法及OLED显示结构，同时具有较高的分辨率及较高的发光效率。

